MARKET NEWS

Infineon präsentiert neue 600 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET Produktfamilie für anspruchsvolle und kosteneffiziente Anwendungen

München, 6. Juni 2024 – Die Infineon Technologies AG stellt die neue 600 V CoolMOS™ 8 Hochspannungs-Superjunction (SJ) MOSFET Produktfamilie vor. Die Bauteile vereinen die besten Eigenschaften der 600 V CoolMOS 7 MOSFET Serie und sind die Nachfolger der Produktfamilien P7, PFD7, C7, CFD7, G7 und S7. Die neuen Superjunction-MOSFETs ermöglichen kostengünstige Lösungen auf Siliziumbasis und bieten neben der Erweiterung des Silizium-Portfolios eine Alternative zu den Produkten von Infineon im Bereich Wide-Band-Gap. Sie sind mit einer integrierten schnellen Body-Diode ausgestattet und eignen sich dadurch für ein breites Spektrum and Anwendungen wie Server- und Industrie-Schaltnetzteile (SMPS), Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und Micro-Solar.

Die Bauteile sind unter anderem in SMD QDPAK-, TOLL- und ThinTOLL 8x8-Gehäusen verfügbar, wodurch die Designs vereinfacht sowie die Montagekosten reduziert werden können. Bei 10 V bieten die 600 V CoolMOS 8 SJ MOSFETs eine um 18 Prozent niedrigere Gate-Ladung (Q_g) als die CFD7-Serie und eine um 33 Prozent niedrigere Gate-Ladung als die P7-Serie. Bei 400 V bieten sie eine 50 Prozent niedrigere Ausgangskapazität C_{OSS} als die CFD7- und P7-Familie. Außerdem wurden die Abschaltverluste im Vergleich zu CFD7 und P7 um 12 Prozent reduziert. Die Sperrverzögerungsladung (Q_{rr}) ist im Vergleich zu CFD7 um 3 Prozent geringer. Die Bauteile bieten zudem die niedrigste Sperrverzögerungszeit (t_{rr}) auf dem Markt. Die thermische Performance wurde im Vergleich zur vorherigen Generation um 14 bis 42 Prozent verbessert.

Aufgrund der genannten Eigenschaften bieten die Bauteile eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit in Soft-Switching-Topologien wie LLC- und ZVS-phasenverschobenen Vollbrückentopologien. Auch in PFC-, TTF- und anderen Hard-Switching-Topologien verfügen sie über hervorragende Leistungswerte. Wegen ihres optimierten Einschaltwiderstands $R_{DS(on)}$ bieten die Bauteile eine höhere Leistungsdichte, sodass Produkte in einer siliziumbasierten Superjunction (SJ)-Technologie auf einen einstelligen Wert von 7 mΩ minimiert werden können.

Infineon wird die neuen 600 V CoolMOS 8 SJ MOSFETs auf der PCIM 2024 in Nürnberg an seinem Stand (Halle 7, Stand 470) präsentieren.

Public / Für die Fachpresse
Informationsnummer INFPSS202406-113d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Veronika Seifried
+49 89 234 61662
veronika.seifried@infineon.com

Investor Relations:
+49 89 234 26655
investor.relations@infineon.com

Verfügbarkeit
Muster der 600 V CoolMOS 8 SJ MOSFETs sind ab sofort erhältlich. Weitere Information sind verfügbar unter www.infineon.com/coolmos8.

Infineon auf der PCIM Europe 2024
Die PCIM Europe findet vom 11. bis 13. Juni 2024 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 7, Stände 470 und 169 präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere Vorträge auf der begleitenden PCIM Conference und den PCIM Foren, gefolgt von Diskussionen mit den Referierenden. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin vereinbaren. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights von Infineon auf der PCIM 2024 sind erhältlich unter www.infineon.com/pcim.

Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com
Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse
Follow us: X - Facebook - LinkedIn

Public / Für die Fachpresse
Informationsnummer INFPSS202406-113d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Veronika Seifried
+49 89 234 61662
veronika.seifried@infineon.com

Investor Relations:
+49 89 234 26655
investor.relations@infineon.com